

Исследование р-п-переходов на основе 4H-SiC, изготовленных имплантацией бора, методом нестационарной емкостной спектроскопии

Ivanov, Pavel; Potapov, Alexander; Samsonova, Tatyana; **Korolkov, Oleg; Sleptšuk, Natalja** Физика и техника полупроводников 2011 / с. 1358-1362 : ил

Низкотемпературный отжиг слаболегированных слоев n-4H-SiC после облучения быстрыми электронами

Korolkov, Oleg; Kozlovski, Vitali; Lebedev, Alexander; **Sleptšuk, Natalja**; Toompuu, Jana; Rang, Toomas Физика и техника полупроводников 2019 / с. 991-994 <https://doi.org/10.21883/FTP.2019.07.47879.9089>

О природе 0,8 эВ полосы фотолюминесценции в легированном теллуриде кадмия

Krustok, Jüri; Lõo, Anu; Piibe, Toomas Физика и техника полупроводников 1990 / 10, с. 1888-1891: рис

Особенности температурного поведения полосы 0,81 эВ фотолюминесценции теллурида кадмия

Krustok, Jüri; Piibe, Toomas; Лыо А.Э. Физика и техника полупроводников 1991 / 7, с. 1257-1259: ил

Свойства поверхности CuInS₂ и влияние на них органических слоев

Verbitsky, Anatoly; Vertsimakha, Yaroslav; Lutsyk, P.N.; Studzinsky, Sergei; **Bereznev, Sergei; Kojs, Julia** Физика и техника полупроводников 2006 / 2, с. 202-206 : ил